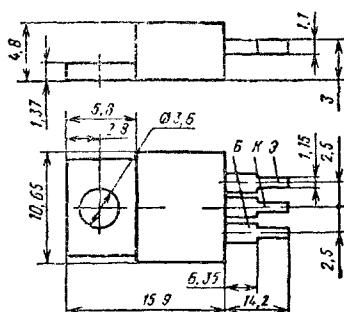


КТ851 (А, Б, В)

КТ851 (А-В)



Транзисторы кремниевые планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности, переключающих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами. Масса транзистора не более 2,5 г.

Электрические параметры

| | |
|--|-------------|
| Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{ДЭ}=10$ В, $I_K=0,5$ А: | |
| КТ851А | 40 200 |
| КТ851Б, КТ851В | не менее 20 |
| Граничное напряжение при $I_D=30$ мА, $t_u \leq 300$ мкс, $Q \geq 100$, не менее: | |
| КТ851А | 200 В |
| КТ851Б | 250 В |
| КТ851В | 150 В |
| Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=0,5$ А, $I_E=0,1$ А, не более | |
| | 1 В |
| Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=0,5$ А, $I_B=0,1$ А, не более | |
| | 1,6 В |
| Обратный ток коллектора при $U_{КБ}=U_{КБ.макс}$, не более: | |
| КТ851А | 100 мкА |
| КТ851Б, КТ851В | 500 мкА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ}=5$ В, не более: | |
| КТ851А | 100 мкА |
| КТ851Б, КТ851В | 500 мкА |

Предельные эксплуатационные данные

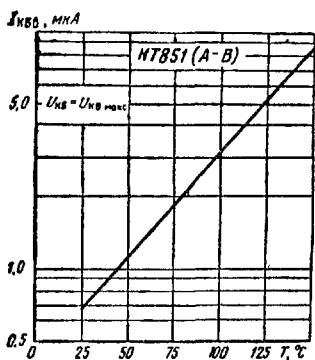
| | |
|--|-------|
| Постоянное напряжение коллектор — база при $(dU_{КБ}/dt)_{макс} \leq 250$ В/мкс: | |
| КТ851А | 250 В |
| КТ851Б | 300 В |
| КТ851В | 180 В |
| Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{сг} \leq 1$ кОм, $(dU_{КЭ}/dt)_{макс} \leq 250$ В/мкс. | |
| КТ851А | 200 В |
| КТ851Б | 250 В |
| КТ851В | 150 В |
| Постоянное напряжение база — эмиттер | |
| | 5 В |
| Постоянный ток коллектора | |
| | 2 А |
| Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 2$ мс, $Q \geq 2$ | |
| | 3 А |
| Постоянный ток базы | |
| | 0,5 А |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом при $T_{к} = -60 \dots +25$ °С | |
| | 25 Вт |

Температура p - n перехода +150 °C
 Температура окружающей среды : : : : : -60 °C... T_n =
 = +100 °C

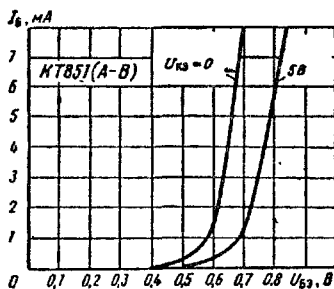
Допускается одноразовый изгиб выводов транзисторов не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° радиусом закругления не менее 0,8 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб выводов в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре не более +260 °C в течение не более 3 с. Допускается пайка волной припоя при температуре не более +240 °C.

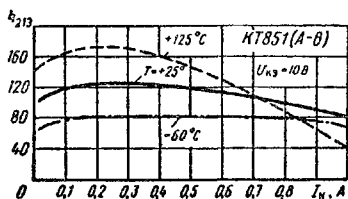
Запрещается припайка основания транзисторов к теплоотводу.



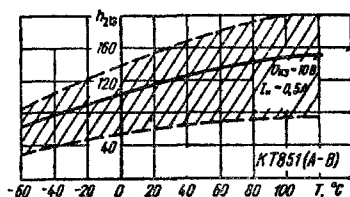
Зависимость обратного тока коллектора от температуры



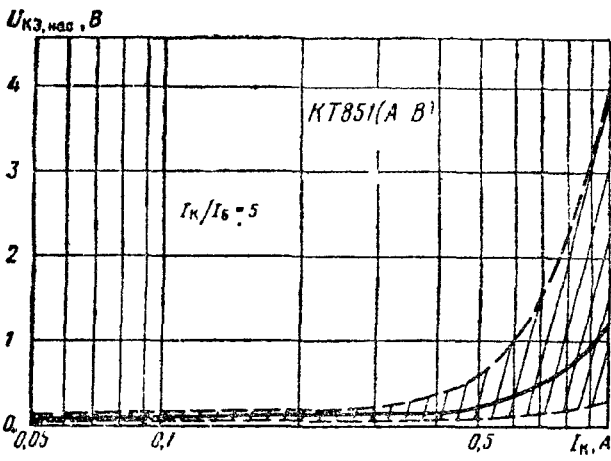
Входные характеристики



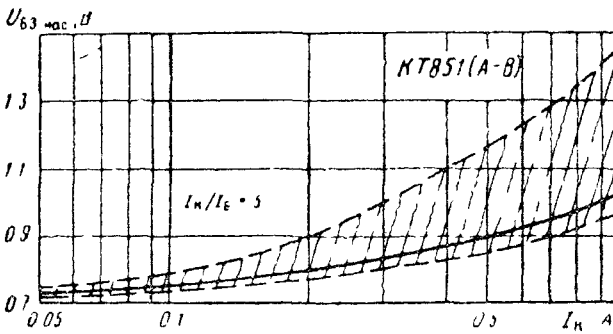
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



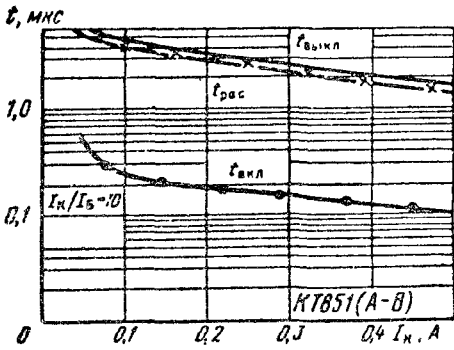
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



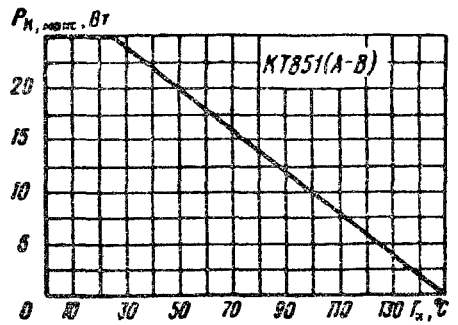
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



Зависимости времени включения выключения и рассеивания от тока коллектора



Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса

Области максимальных режимов

